

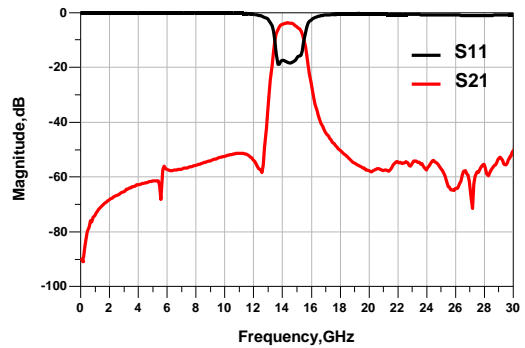
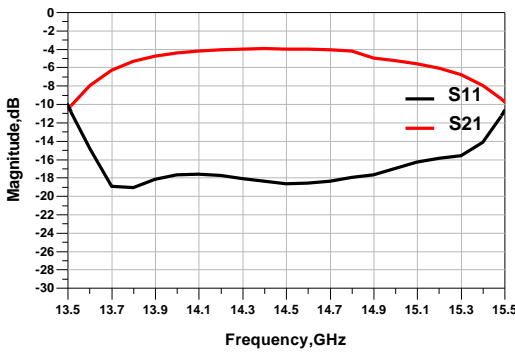
性能特点：

- 3dB频率范围：14-15GHz；
- 中心频率损耗：≤4.3dB；
- 阻带衰减：≥30dB (DC-13GHz)；≥25dB@16GHz；
- 芯片尺寸：3.50×2.05×0.1mm；
- 输入输出阻抗：50Ω；

产品简介：

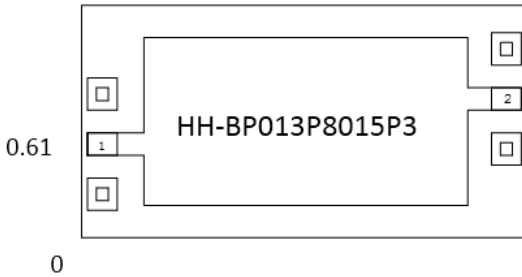
HH-BP013P8015P3 型 GaAs 带通滤波器芯片的特点是窄带、频率选择性高，带外抑制强，且体积小，重量轻，适合应用于微系统集成的上下变频模块、TR 组件及微波毫米波系统中。该芯片输入输出均为 50Ω，设计上采用良好接地，使用方便，可采用共晶焊或导电胶粘结。

典型曲线：



尺寸图：

2.05

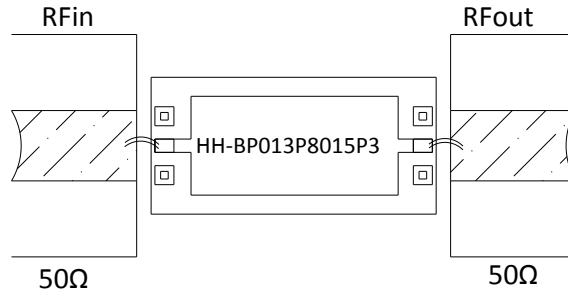


1.74

3.50

说明：

1. 单位：毫米，公差：±0.05mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸：0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

芯片装配图：


- 1、RFin 为信号输入端口，压点 1 通过两根金丝键合连接 50 欧姆微带线 1；
- 2、RFout 为信号输出端口，压点 2 通过两根金丝键合连接 50 欧姆微带线 2；
- 3、芯片背面及 50 欧姆微带线背面接地。

使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。